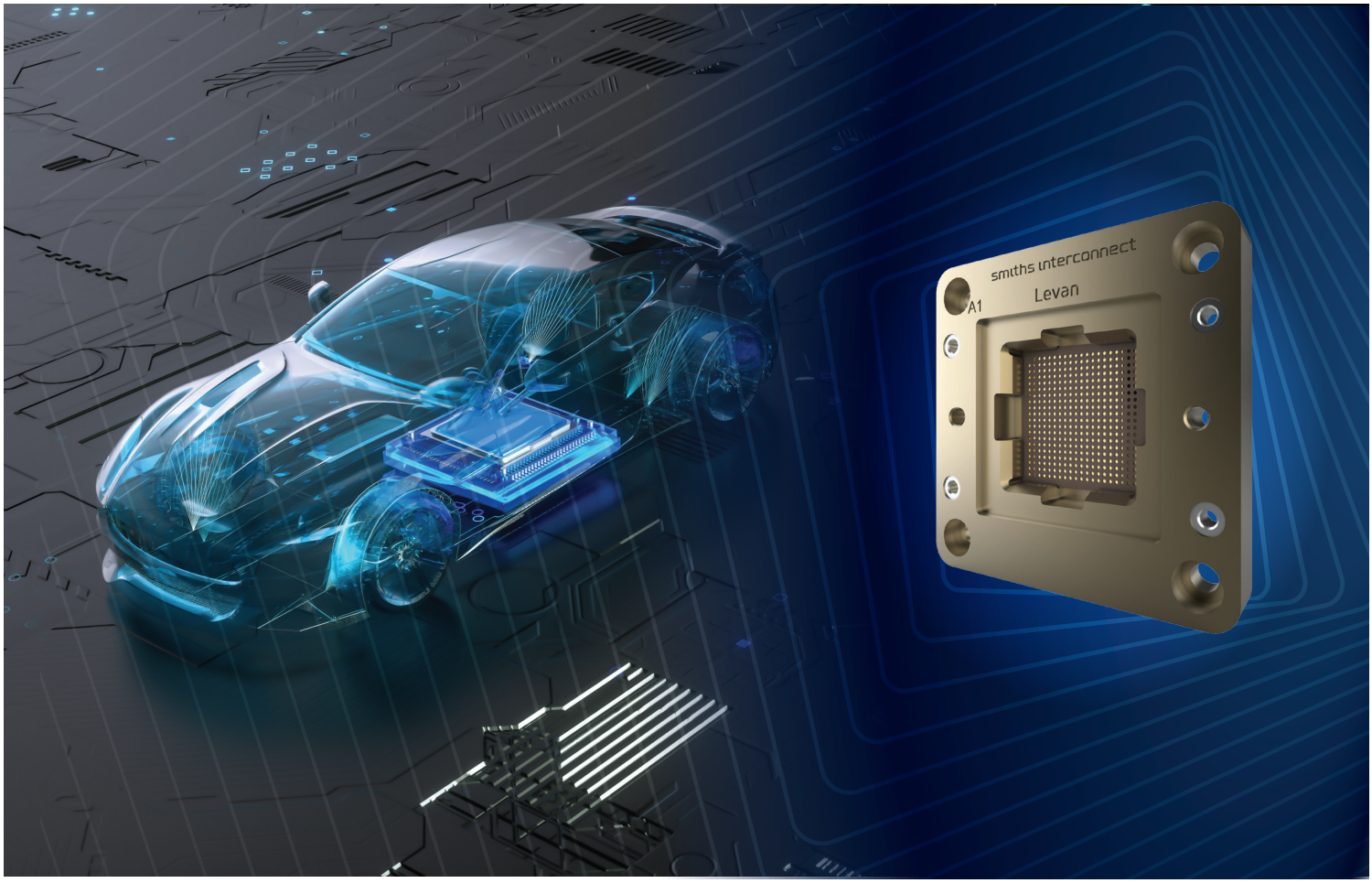
smiths interconnect
a molex company

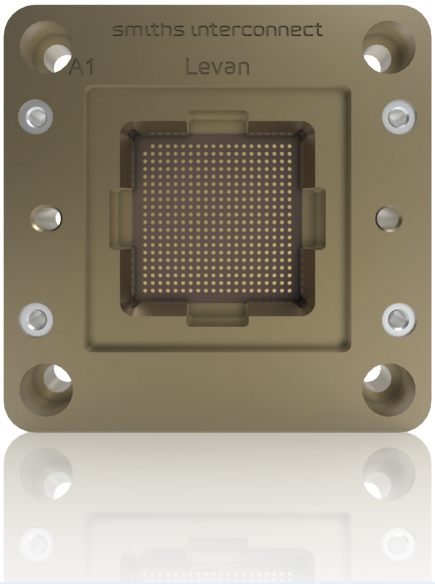
Levan 엘라스토머 접촉식 테스트 소켓

IC 테스트용 고대역폭 테스트 소켓



Levan 엘라스토머 접촉식 테스트 소켓

IC 테스트용 고대역폭 테스트 소켓



정밀하게 설계된 Levan 엘라스토머 소켓 제품군을 소개합니다. Levan의 엘라스토머 그리드에는 도전성 컬럼이 적용되어 다양한 디바이스에서 정확하고 일관된 테스트 결과를 제공합니다. BGA, LGA, QFN 및 기타 패키지 유형에 적합한 테스트 솔루션입니다.

높은 대역폭과 낮은 인덕턴스 덕분에 테스트 시스템에 미치는 전기적 영향이 거의 없으며, 피시험 소자(DUT)의 솔더 볼 손상을 방지하고 탁월한 전기적·기계적 이점을 제공합니다. Levan은 엔지니어링 단계부터 대량 양산에 이르기까지 다양한 테스트 요구 사항을 충족하며, 다양한 테스트 환경에 적용할 수 있으며 비용 효율성을 제공합니다.

제품 특징

- BGA, LGA, QFN 및 기타 패키지 유형을 위한 솔루션
- RF 대역폭: 23~108 GHz
- 짧은 신호 경로: ≤ 0.9 mm
- 신호의 임피던스 정합 가능
- 일정하고 안정적인 접촉 저항: 평균 100 mΩ
- 낮은 인덕턴스
- 테스트 애플리케이션에 따른 최적화 설계
- 저온·상온·고온 테스트를 지원하는 소켓 설계(-55 °C ~ +160 °C)
- 동일한 소켓으로 수동 테스트, 벤치 테스트 및 대량 양산 테스트를 수행하도록 설계

주요 이점

- 요구 사항에 맞춘 설계 적용
- 신호 전달에 미치는 전기적 영향 최소화
- 임피던스 정합
- 우수한 DC 성능
- 애플리케이션에 맞춘 설계로 수율 및 제품 수명 향상
- 정밀 가공된 소켓 하우징으로 견고한 기계적 성능 확보
- 현장 수리 및 Levan 엘라스토머의 간편한 교체
- 간편한 세정
- 기존 PCB의 소켓 풋프린트 및 테스트 하드웨어와 호환되어 고객 비용 절감
- 프로브 소켓 대비 짧은 납기

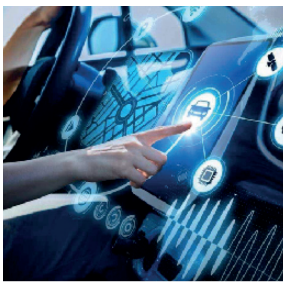
주요 적용 시장



통신


컴퓨팅


소비자용 전자제품

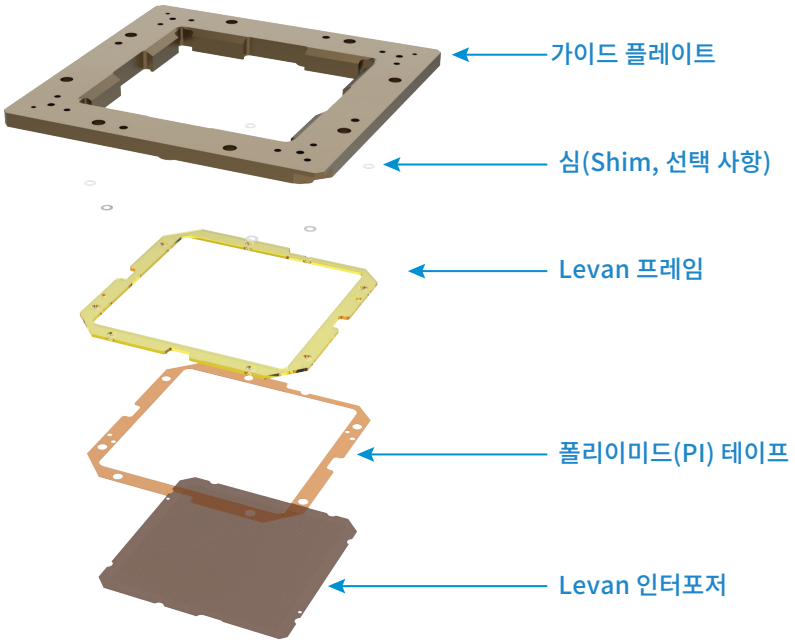

자동차


데이터센터

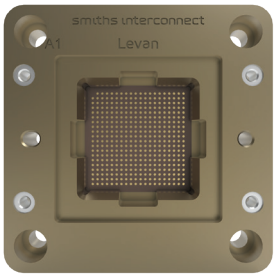
Levan 엘라스토머 접점

smiths interconnect
a molex company

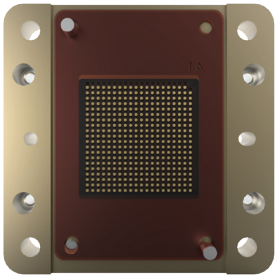
제품 구조



전면



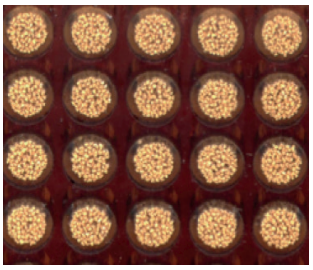
후면



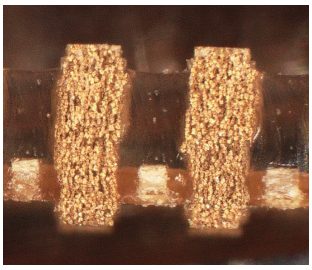
제품 사양

재료	
도전성 입자	금 도금 니켈 (Au Plated Ni)
고정 프레임	플라스틱 또는 스테인리스강
본체	실리콘 [Silicon]
전기적 특성	
접촉 저항 (mΩ)	30~50
대역폭 (-1 dB 기준, GHz)	23~108
반사 손실 기준 주파수(-10 dB 기준, GHz)	10~110
자기 인덕턴스(Self-inductance, nH)	0.08~0.29
기계적 특성	
패키지 유형	BGA/LGA/QFN/QFP
작동 온도 (°C)	일반 : -40°C~ +125°C 특수: -55°C ~ +160°C
테스트 스트로크 (mm)	0.15 (최대 0.25)
접촉력 (gf/핀)	8 ~ 55
기계적 수명(접촉 횟수, T/D)	ATE: 50,000회 미만 [부등호 및 보증 기준 확인 후 확정]
적용 사양	
피치 (mm)	0.3 ~ 1.27
최대 핀 수	< 8,000

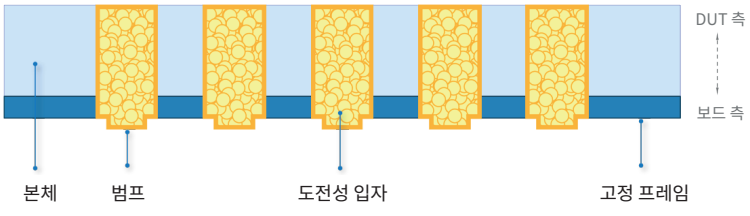
컬럼 배열

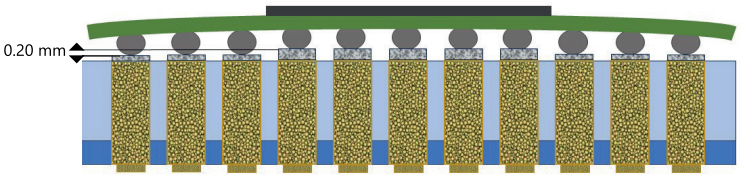


단면도



구조





패키지 접점의 높이 편차(공면도 공차)에 대응하도록 중앙부 어레이의 도전성 컬럼 높이를 높였습니다.
(컬럼은 IC 어레이 내 어느 위치에나 배치할 수 있습니다.)

Levan 엘라스토머 제품 옵션

제품 적용 분야

- CN – 대부분의 애플리케이션에 적합합니다.
- CM – 양산 테스트 환경에서 사용되는 메모리 애플리케이션용으로 개발되었습니다.
- CW – 대형 BGA 디바이스의 정렬을 위한 Kapton 볼 가이드가 포함되어 있습니다. 미세 피치 BGA의 양산 테스트에도 적합합니다.
- PiS – 솔더 볼 손상 방지와 수명 연장을 고려한 설계로, 시스템 레벨 테스트(SLT) 등 양산 테스트에 적합합니다.
- mPiS – 초미세 피치 메모리 및 SoC 애플리케이션용으로 설계되었습니다.

유형	피치	접촉력	대역폭(-1 dB 기준, GHz) [제조사 확인 후 확정]	주요 적용 분야
CN	0.3 ~1.27mm	8~55gf/핀	23.4~108GHz	로직 IC 평가·개발 및 핸들러 테스트
CM	0.8mm	45gf/핀	66.9 GHz	메모리 IC: DRAM DDR2 및 DDR3, GDDR3 및 GDDR5
CW	0.4~1.27mm	10~35gf/핀	51~102 GHz	미세 피치 및 다핀 메모리: DDR4 및 DDR5, LP-DDR; 로직 IC, SoC IC, RF IC
PiS	0.35~1.27mm	10~30gf/핀	51~102 GHz	미세 피치 및 자동차용 메모리 IC: DDR4 및 DDR5, LP-DDR
mPiS	0.3~0.35mm	8~16gf/핀	91~104 GHz	미세 피치 메모리 IC: LP-DDR

Copyright© 2026 Smiths Interconnect, a Molex company / 모든 권리 보유 / 버전 2.0
본 문서에 포함된 정보에는 관련 수출 통제 규정 및 법적 요구 사항이 항상 적용됩니다.